

Секция 8

Диэлектрики в экстремальных условиях

Произносимые доклады расположены в порядке выступления

Руководители секции:	Закревский Владимир Александрович (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург), Сударь Николай Тобисович (СПбПУ, Санкт-Петербург)
Ученый секретарь:	Каблукова Наталья Сергеевна (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

Произносимые

1. *Бурковский Р.Г.^{1,2}, Бронвальд Ю.А.^{1,2}, Андроникова Д.А.^{1,2}, Князева М.А.¹, Филимонов А.В.¹, Вахрушев С.Б.^{1,2}, Таганцев А.К.^{2,3}* Несоразмерные фазы в антисегнетоэлектриках в условиях высокого давления (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого¹, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе²; Lausanne, Switzerland, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL)³)
2. *Гольдман Е.И., Левашов С.А., Нарышкина В.Г., Чучева Г.В.* Исследования методом высокочастотных вольтфарадных характеристик структур металл-сверхтонкий окисел-полупроводник, подвергнутых повреждению при полевоом стрессе (Фрязино, Россия, Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН)
3. *Закревский В.А.¹, Пахотин В.А.¹, Сударь Н.Т.²* Импульсный электрический пробой пленок полипропилена (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе¹, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого²)
4. *Петухов К.А., Попов В.Д.* Исследование поверхностного дефектообразования при низкоинтенсивном облучении гамма-лучами (Москва, Россия, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ)
5. *Крылов В.П.* Метод определения природы проводимости диэлектриков (Обнинск, Россия, АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»)

Стендовые

1. *Гольдман Е.И., Киселев Д.А., Чучева Г.В.* Исследования локальных электрических предпробойных воздействий на тонкие слои окисла кремния (Фрязино, Россия, Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН)

2. *Крылов В.П., Суханов И.Е., Горшков Н.А., Титов Н.С., Шадрин А.П., Емельянов И.В., Неповинных О.В., Метелкин А.С., Королев Д.А.* Стенд для измерения на СВЧ диэлектрических свойств материалов при нормальных условиях в полосе частот от 8 до 26 ГГц и в полосе частот от 8 до 12 ГГц при нагреве до 2000°C (Обнинск, Россия, АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»)
3. *Крылов В.П., Суханов И.Е., Горшков Н.А., Титов Н.С., Шадрин А.П., Емельянов И.В., Неповинных О.В., Метелкин А.С., Королев Д.А.* Установка для измерения диэлектрических свойств материалов на СВЧ при нагреве до 1200°C (Обнинск, Россия, АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»)
4. *Пахотин В.А., Закревский В.А.* Временные и спектральные характеристики тока пробоя органических диэлектриков (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе)
5. *Удовенко С.А.¹, Андроникова Д.А.^{1,2}, Вахрушев С.Б.^{1,2}* Разработка методики проведения дифракционных экспериментов при приложении электрического поля к исследуемому образцу (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого¹, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе²)